

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 3 区分

【発行日】平成30年3月22日 (2018.3.22)

【公開番号】特開2018-14643(P2018-14643A)

【公開日】平成30年1月25日 (2018.1.25)

【年通号数】公開・登録公報2018-003

【出願番号】特願2016-143660(P2016-143660)

【国際特許分類】

H 0 3 H 9/17 (2006.01)

H 0 3 H 3/02 (2006.01)

【F I】

H 0 3 H 9/17 F

H 0 3 H 3/02 B

【手続補正書】

【提出日】平成30年2月7日 (2018.2.7)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 5 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 5 1】

図 8 は、実施例 1 の変形例 1 に係る圧電薄膜共振器の共振領域の断面図である。図 8 のように、圧電膜 1 4 は、下部電極 1 2 と第 2 領域 1 4 b との間に下部電極 1 2 に接する第 3 領域 1 4 c を有する。第 3 領域 1 4 c は、他の元素が添加されていない A l N 膜（すなわち、ノンドープ A l N 膜）からなる。第 3 領域 1 4 c は、第 1 領域 1 4 a 及び第 2 領域 1 4 b の A l N 膜を形成する前に、窒素を含む雰囲気下で、アルミニウムターゲットを用いたスパッタリング法によって形成することができる。その他の構成は、実施例 1 と同じであるため説明を省略する。